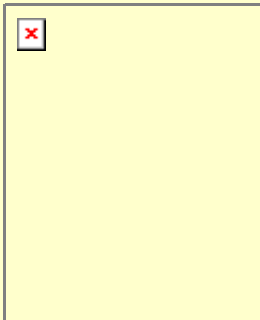


## 本期封面



2000年5

栏目:

DOI:

论文题目: 高能ZnO基复合陶瓷线性电阻的制备

作者姓名: 袁方利(1), 林元华(1), 黄淑兰(1), 李晋林(1), 季幼章(2)

工作单位: 1. 中国科学院化工冶金研究所, 2. 中国科学院等离子体物理研究所

通信作者: 袁方利

通信作者Email:

文章摘要: 在ZnO中添加Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>和MgO, 制备了高能ZnO基复合陶瓷线性电阻, 其电阻率为5-1300Ω·cm、能量密度大于450J/cm<sup>3</sup>、电阻温度系数小且近于线性. 烧结温度、MgO添加量和降温速率分别对材料的电阻率、电阻温度特性以及线性度和能量密度有较大影响.

关键词: ZnO陶瓷, 线性电阻, 制备

分类号:

关闭